

# JCGC250150HE 型氮化镓射频功率管

## 28V、150W氮化镓射频功率管

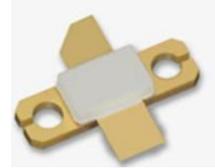
### 简介

JCGC250150HE是一款150W未匹配的氮化镓射频功率管,为多应用场景设计,其工作频率最高可达2.5GHz。

•典型的电气特征,  $V_{DD}=28V$   $I_{DQ}=100mA$ , CW,  $V_{GS}=2.71V$ 。

频率 MHz	输入功率 dBm	输出功率 dBm@Psat	输出功率 W@Psat	漏源电流 A	增益 dB	效率 %
1100	35.3	51.6	145	7.1	16.3	72
1200	35.1	50.9	123	5.7	15.8	77
1300	35.2	50.9	123	6.2	15.7	71
1500	38.5	51.68	147.2	7.6	13.18	69
1600	38	51.47	140.3	7.07	13.47	71
1700	38.3	50.85	121.6	5.98	12.55	73

### JCGC250150HE



### 应用和特性

- 适用于无线通信基础设施, 宽带放大器, EMC测试, ISM等。
- 高效率和线性放大。
- 极好的散热能力。
- 高可靠的金属化制程。
- 出色的热稳定性和健壮性。
- 符合有害物质限制(RoHS) 2002/95/E标准。

**特别提醒: JCGC250150HE要求严格的加电顺序。**

#### 上电顺序:

- 1.将栅极电压VGS设置到夹断电压点 (V pinch off, VP), 典型值为-5V;
- 2.开启漏压VDS, 典型值为28V;
- 3.调整VGS直到期望的静态电流IDS;
- 4.输入射频功率并开始工作。

#### 下电顺序:

1. 关闭射频输入;
2. 降低VGS至VP, 典型值为-5 V;
3. 关闭VDS, 直至VDS降低到0V;
4. 关闭VGS。

**表1. 极限参数 (TC = 25°C)**

参数	符号	极限值	单位
漏源电压	$V_{DSS}$	150	Vdc
栅源电压	$V_{GS}$	-10,+2	Vdc
工作电压	$V_{DD}$	40	Vdc
最大前向栅源电流	$I_{gmax}$	36	mA
贮存温度范围	$T_{stg}$	-65 to +150	°C
管壳工作温度	$T_c$	+150	°C
工作结温(见注 1)	$T_j$	+225	°C
器件总耗散功率(超过 25°C 需要降额, 见注 2)	$P_{diss}$	165	W
<b>注1: 在最高结温下长时间工作将影响MTTF</b>			
<b>注2: 偏置条件应满足: <math>P_{diss} &lt; (T_j - T_c) / R_{JC}</math> and <math>T_c = T_{case}</math></b>			

# JCGC250150HE 型氮化镓射频功率管

**表2. 热特性**

典型条件	符号	值	单位
热阻, T <sub>c</sub> = 85°C, T <sub>j</sub> =200°C, 直流功率耗散(见注)	R <sub>θJC-DC</sub>	1.2	°C/W

注: R<sub>θJC-DC</sub> 为功率管只加静态电流下测试得到的热阻, 其得到的数据是功率管各种工作条件下最大的。其他的工作条件下, 如连续波工作、脉冲工作时, 测得的 R<sub>θJC</sub> 通常比 R<sub>θJC-DC</sub> 略小。

**表 3. 主要电特性(T<sub>c</sub> = 25°C)**
**直流特性**

参数	测试条件	符号	最小	典型值	最大	单位
漏源击穿电压	V <sub>GS</sub> =-8V; I <sub>DS</sub> =36mA	V <sub>DSS</sub>	150			V
栅极阈值电压	V <sub>DS</sub> = 28V, I <sub>D</sub> =36mA	V <sub>GS(th)</sub>	-4		-2	V
栅极静态电压	V <sub>DS</sub> =28V, I <sub>DS</sub> =100mA	V <sub>GS(Q)</sub>		-2.71		V

**功能测试 (50 Ω 系统,1.6G窄带):** V<sub>DD</sub> = 28 Vdc, I<sub>DQ</sub> = 80mA, f = 1650 MHz, CW

参数	符号	最小	典型值	最大	单位
功率增益@P <sub>Sat</sub>	G <sub>p</sub>		14.3		dB
漏极效率@P <sub>Sat</sub>	Eff		71.3		%
饱和功率	P <sub>SAT</sub>		52.7		dBm
输入回波损耗	IRL		-7		dB
全相位抗失配能力(器件无损坏)	VSWR		10:1		Ψ

## 外形

带法兰陶瓷封装; 2 引线

**表 4. 引脚定义**

序号	引脚标号	引脚定义
1	1	漏极/RF OUT
2	2	栅极/RF IN
3	3	源极

